

株式会社 トリケミカル研究所

第40期(2018年1月期)

第2四半期決算説明資料

東京証券取引所JASDAQ市場
証券コード:4369

2017.9

1. 2018年1月期第2四半期決算実績

2018年1月期第2四半期業績の概要(総括)

単位:百万円

	18.1期 上期実績	18.1期 上期計画	計画比	(ご参考) 17.1期 上期実績	(ご参考)前年同期比	
					増減額	増減率
売上高	2,955	2,900	101.9%	2,789	165	5.9%
営業利益	757	660	114.8%	495	261	52.8%
経常利益	766	650	117.9%	461	305	66.1%
当期純利益	533	440	121.2%	405	128	31.6%

！今期も半期としては創業来最高の売上高・利益を達成
！利益率は前年同期比大幅改善

貸借対照表

単位:百万円

	(ご参考) 17.1期末	17/7月末	増減額
流動資産	4,041	4,225	184
固定資産	3,013	3,603	589
資産合計	7,055	7,829	774
流動負債	1,903	2,100	197
固定負債	1,080	1,252	171
負債合計	2,984	3,352	368
株主資本	4,065	4,473	408
評価・換算差額等	5	2	-2
純資産合計	4,071	4,476	405
負債純資産合計	7,055	7,829	774

主な増減要因

流動資産

現金及び預金の減少	-105
売上債権の増加	220
棚卸資産の増加	50

固定資産

韓国合弁会社の増資引受に伴う増加	527
台湾子会社設立に伴う増加	38

流動負債

1年内返済予定の長期借入金の増加	77
未払法人税等の増加	57

固定負債

長期借入金の増加	169
----------	-----

純資産

当期純利益計上等による利益剰余金の増加	408
---------------------	-----

キャッシュ・フロー

単位:百万円

	(ご参考) 17.1期上期	18.1期上期
営業活動による キャッシュ・フロー	308	560
投資活動による キャッシュ・フロー	-479	-786
財務活動による キャッシュ・フロー	-116	120
現金及び現金 同等物の増減額	-290	-105
現金及び現金同等 物の四半期末残高	540	1,390

各CFの状況等

営業CF

税前純利益計上	766
減価償却費計上	187
売上債権の増加	-220
法人税等の支払額	-193

投資CF

有形固定資産の取得	-219
関係会社株式の取得	-565

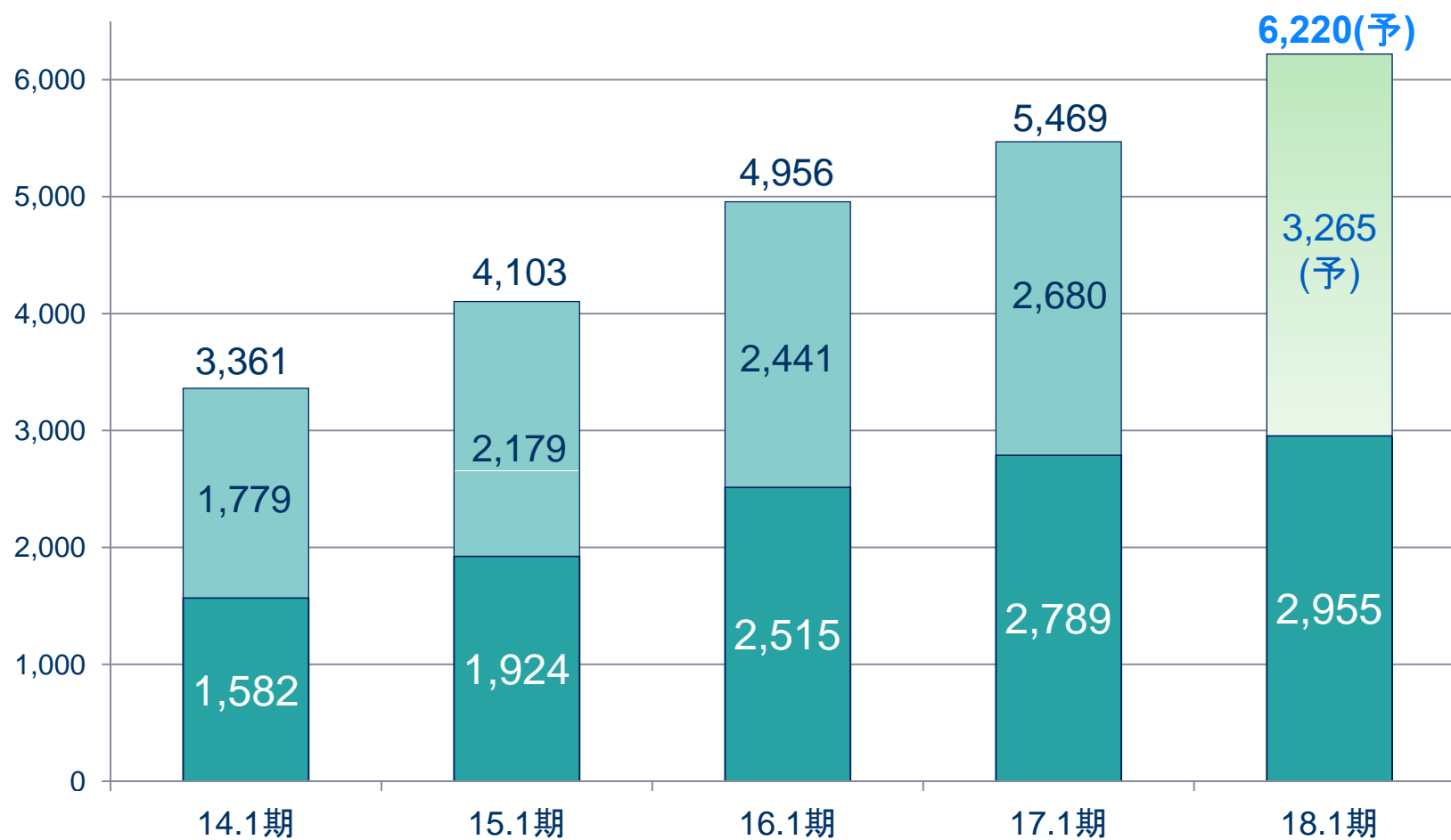
財務CF

長期借入金調達・返済	246
配当金の支払	-124

販売実績

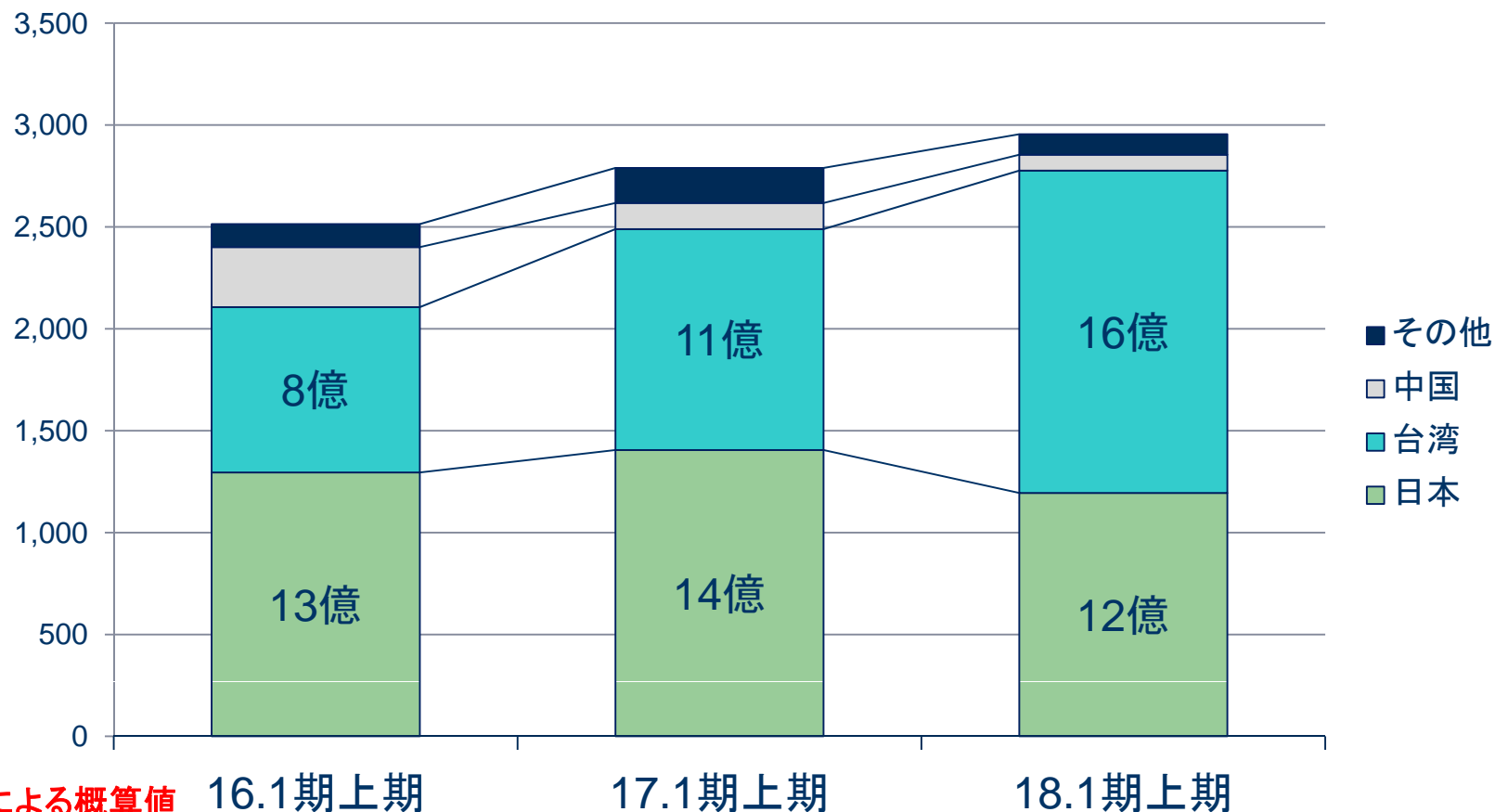
単位:百万円

(下部は上期実績)



売上分析(ユーザー地域別)

単位: 百万円

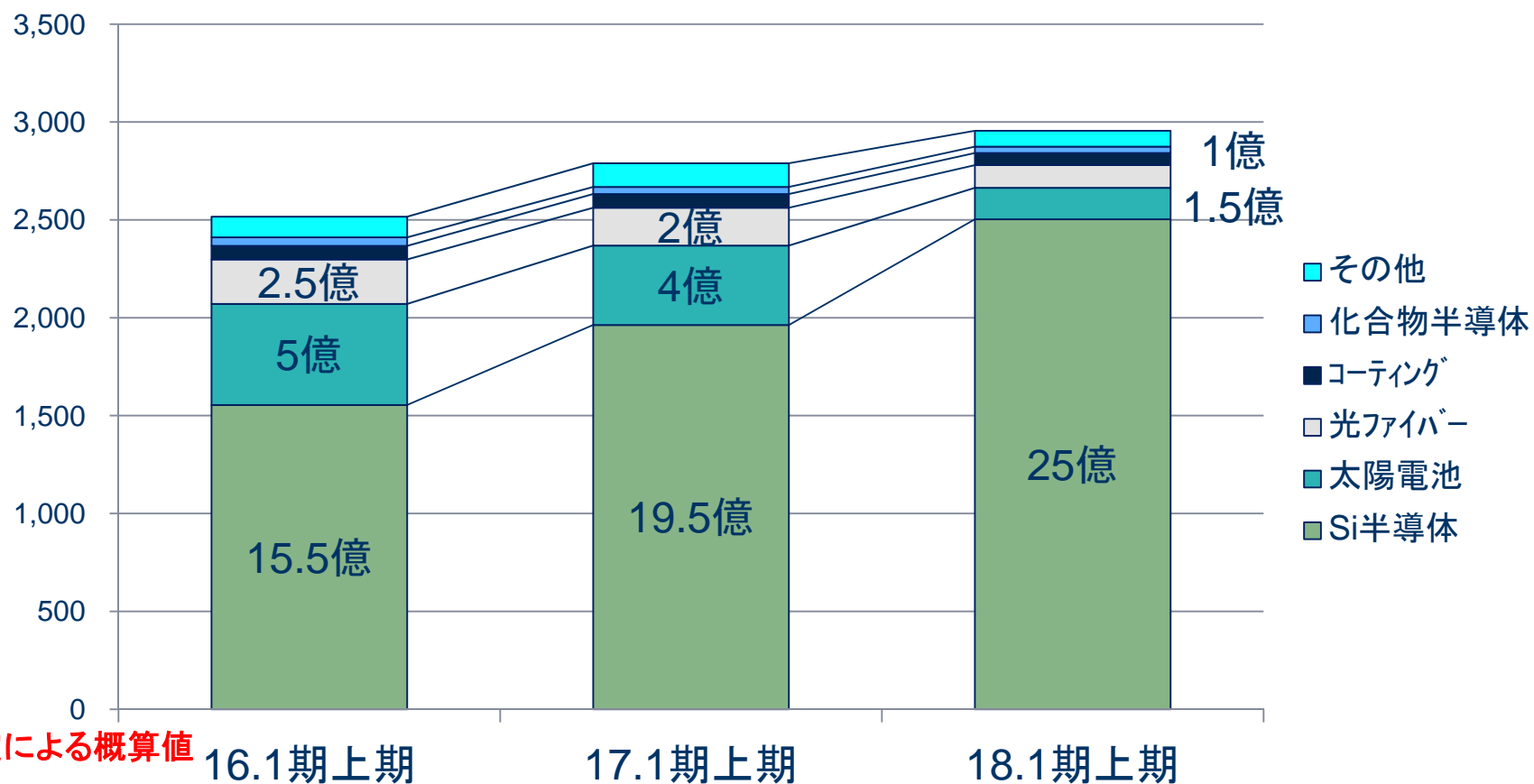


※当社推定による概算値

！ 太陽電池材料の低迷等により国内向けは減少(当初想定通り)
 ! 台湾向け売上は大幅増、国内向け売上を上回る

売上分析(製品用途別)

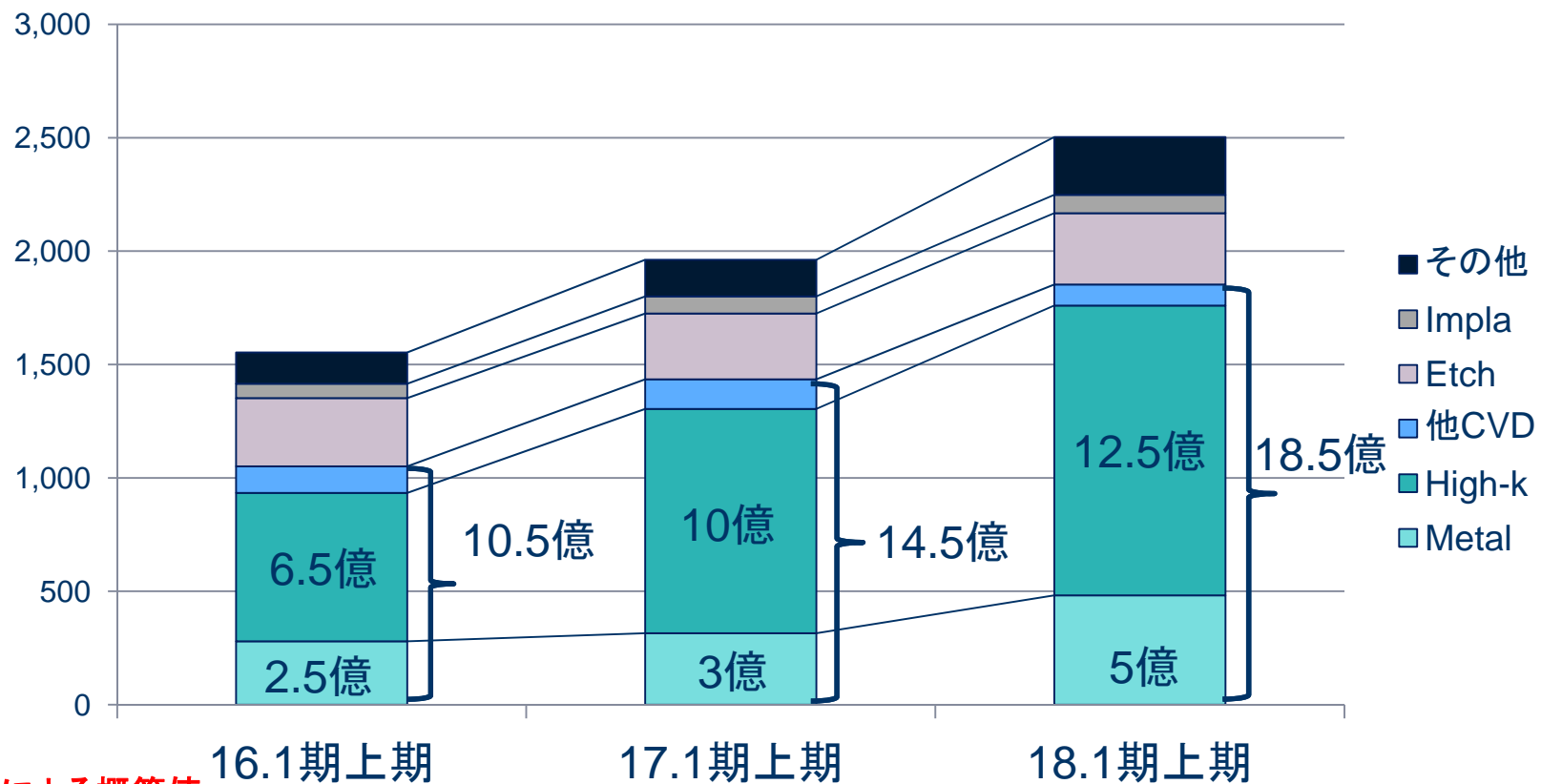
単位:百万円



！ 太陽電池、光ファイバー向けの落ち込みを半導体向けでカバー

売上分析(Si半導体)

単位:百万円

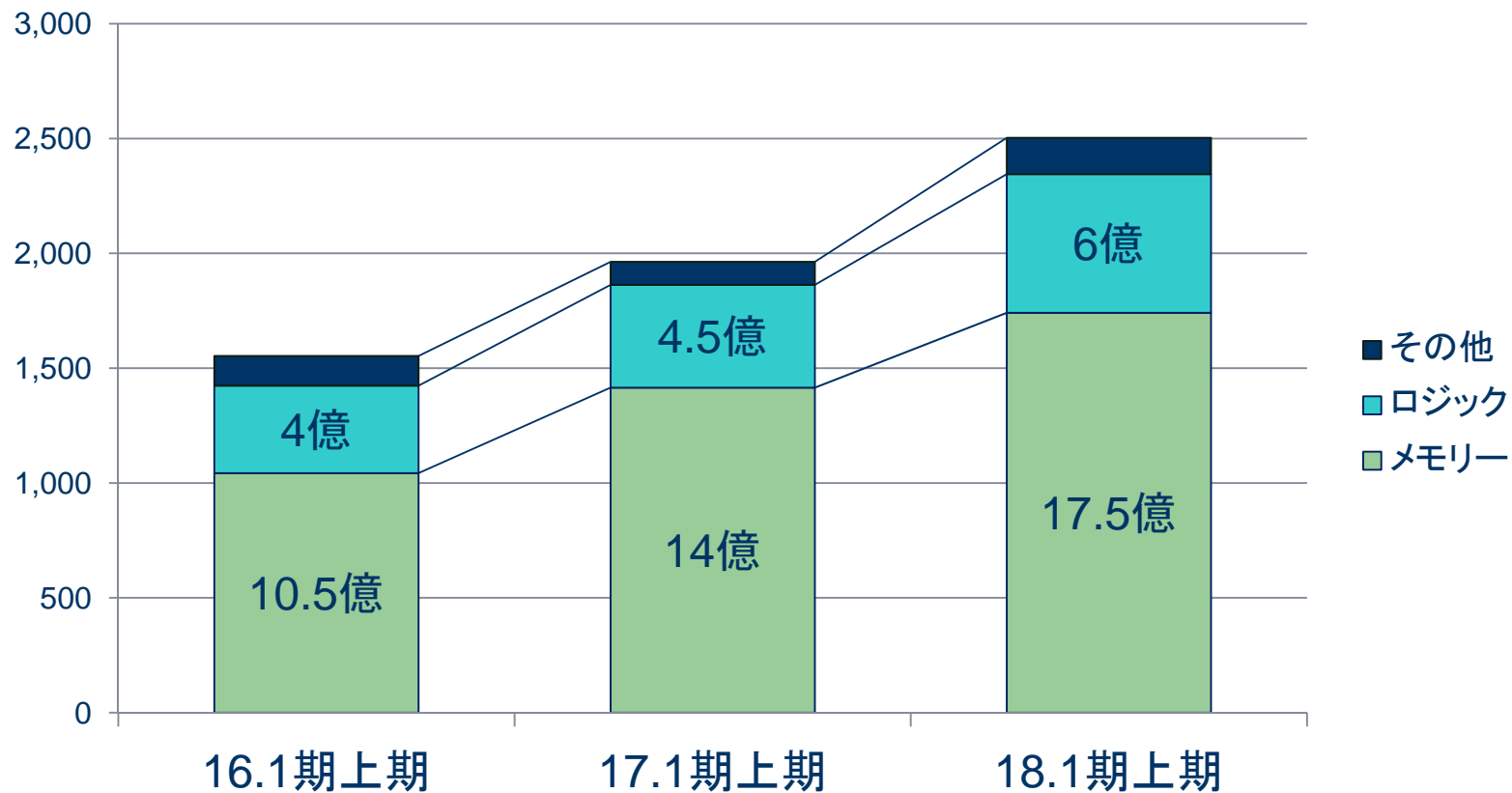


※当社推定による概算値

！ CVD系材料、特にHigh-k向け、Metal向け材料が牽引

売上分析(半導体向け先別)

単位:百万円

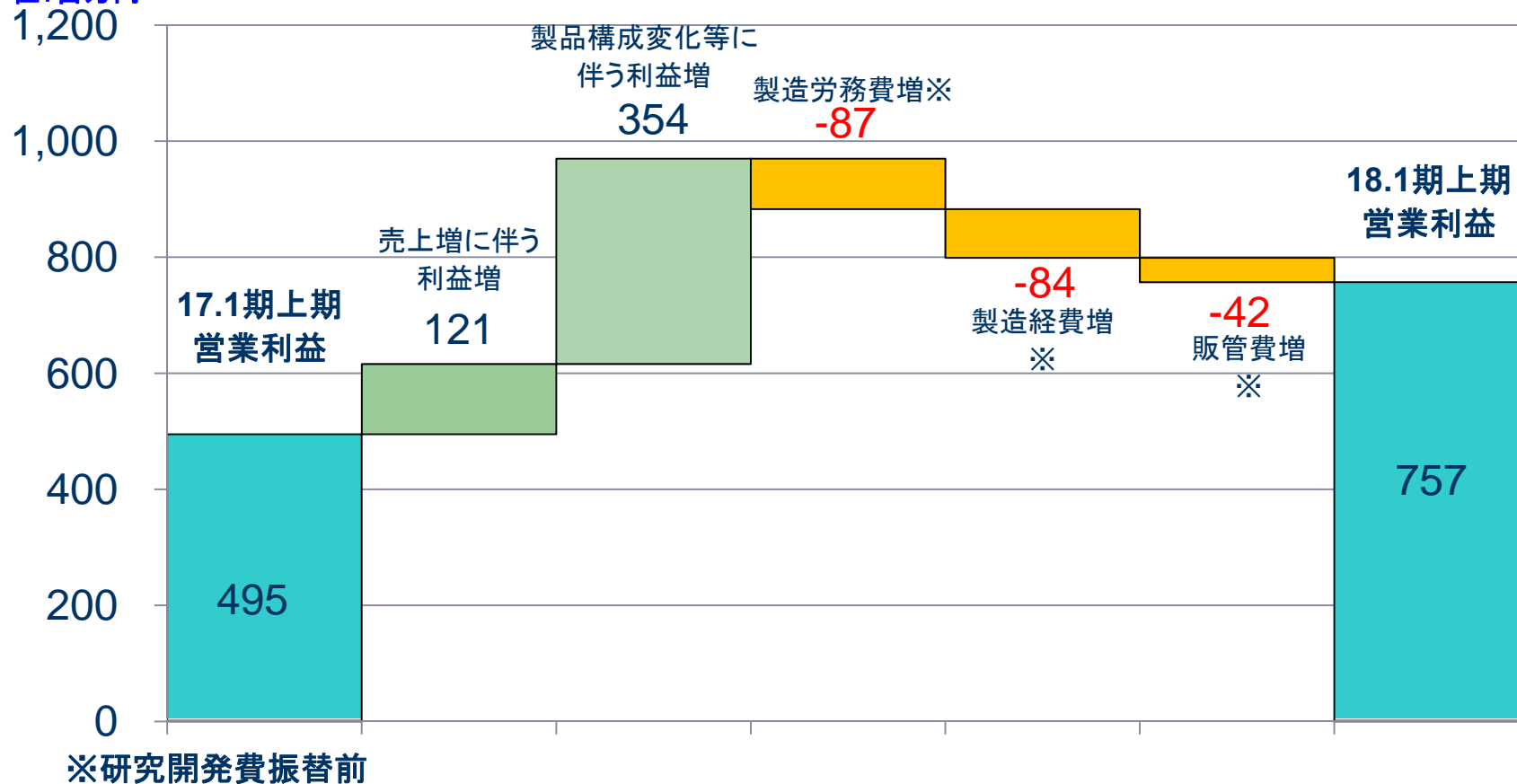


※当社推定による概算値

！メモリー向け、ロジック向け共に売上増

2018年1月期営業利益増減要因

単位:百万円



**！収益性の高い新規材料出荷量の増加、
新工場稼働による全社的な生産性向上等による大幅改善**

2. 2018年1月期通期見通し及び戦略

2018年1月期通期見通し

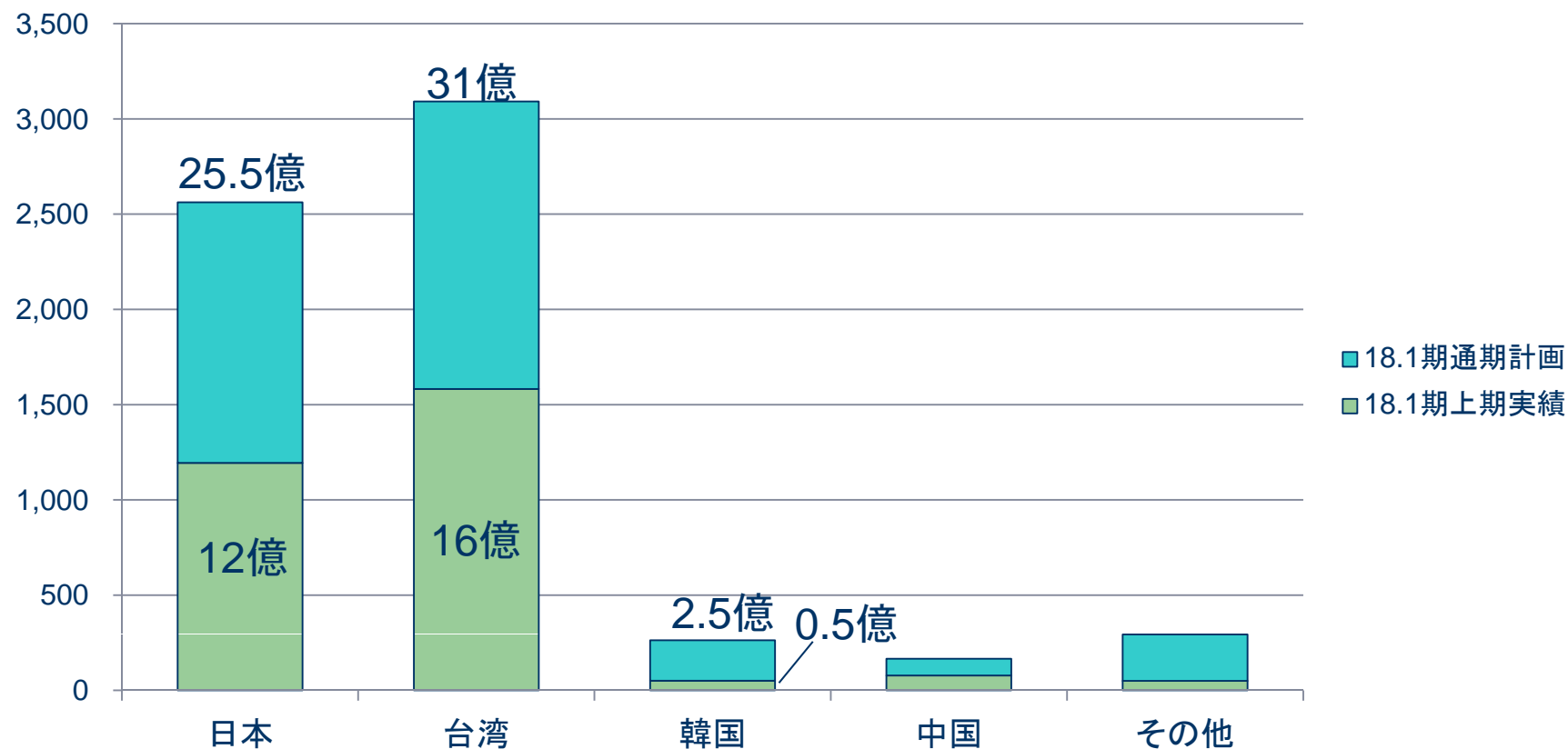
単位: 百万円

	18.1期上期	18.1期通期 (計画)	進捗率	(ご参考) 17.1期通期
売上高	2,955	6,220	47.5%	5,469
営業利益	757	1,560	48.6%	976
経常利益	766	1,540	49.8%	975
当期純利益	533	1,050	50.8%	767

！ 下半期にかけてさらに成長を目論む

売上進捗分析(ユーザー地域別)

単位:百万円

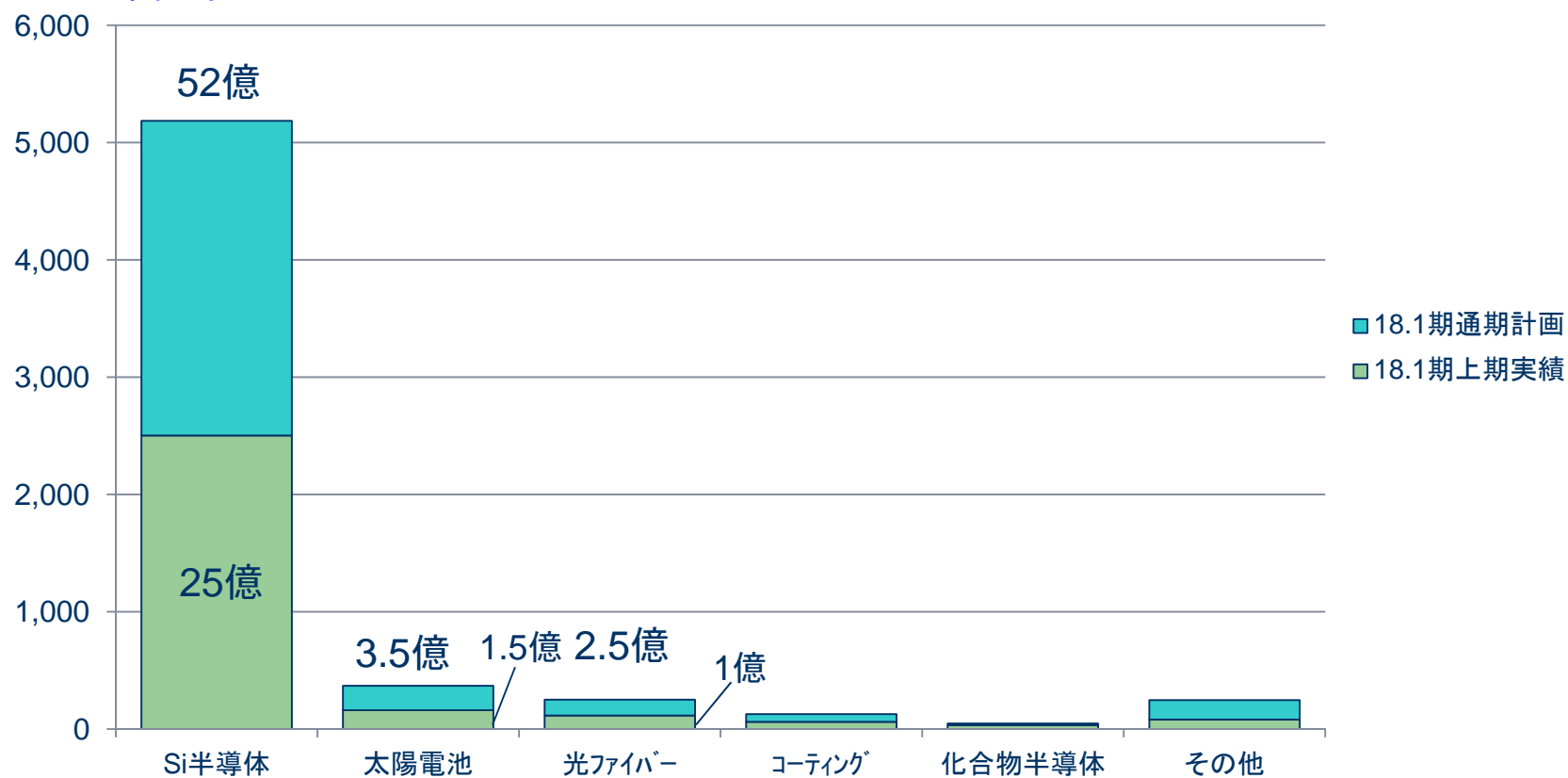


※当社推定による概算値

！韓国向け売上の成長がカギ

売上進捗分析(製品用途別)

単位:百万円

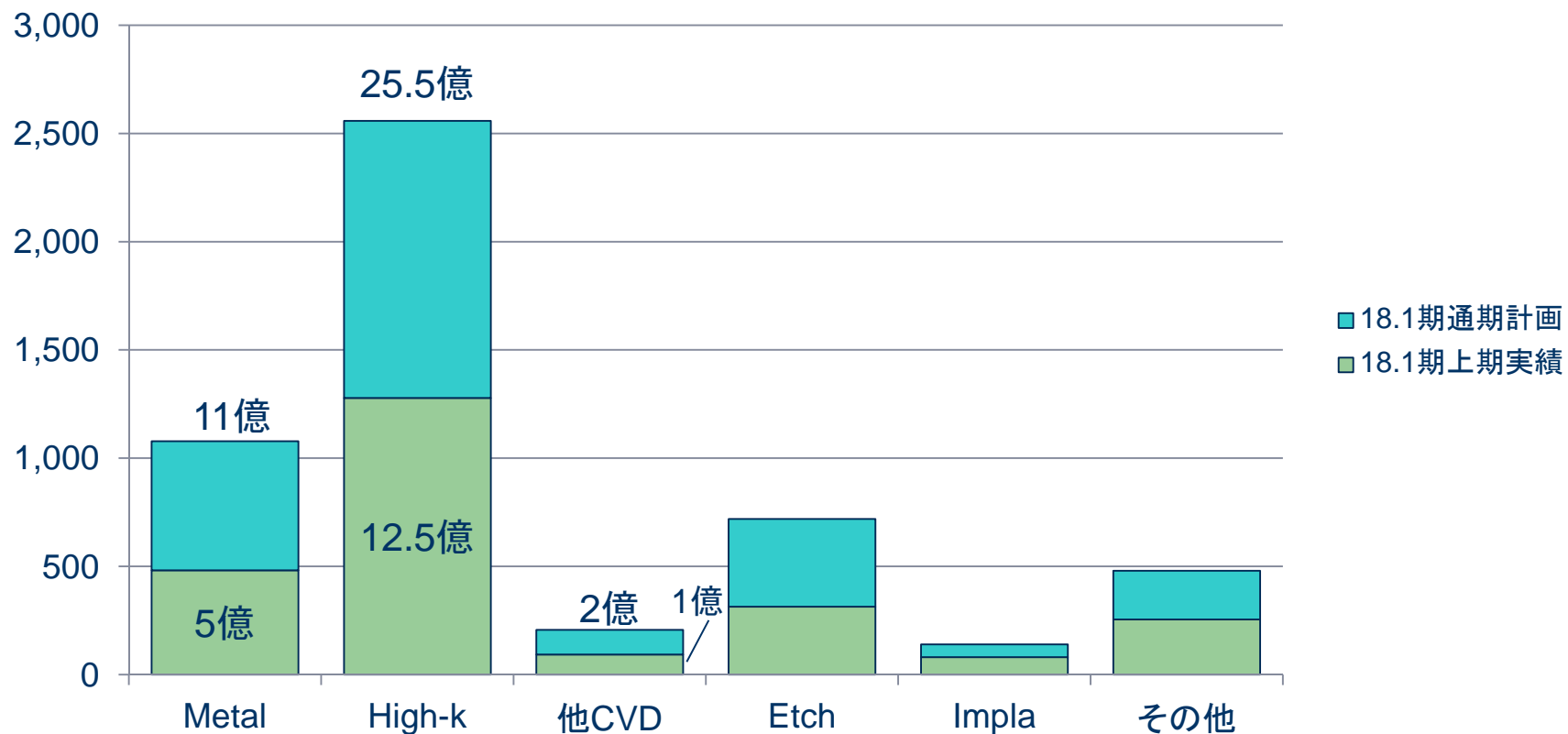


※当社推定による概算値

！半導体向け材料売上は下期さらに増加見込み

売上進捗分析(Si半導体)

単位:百万円

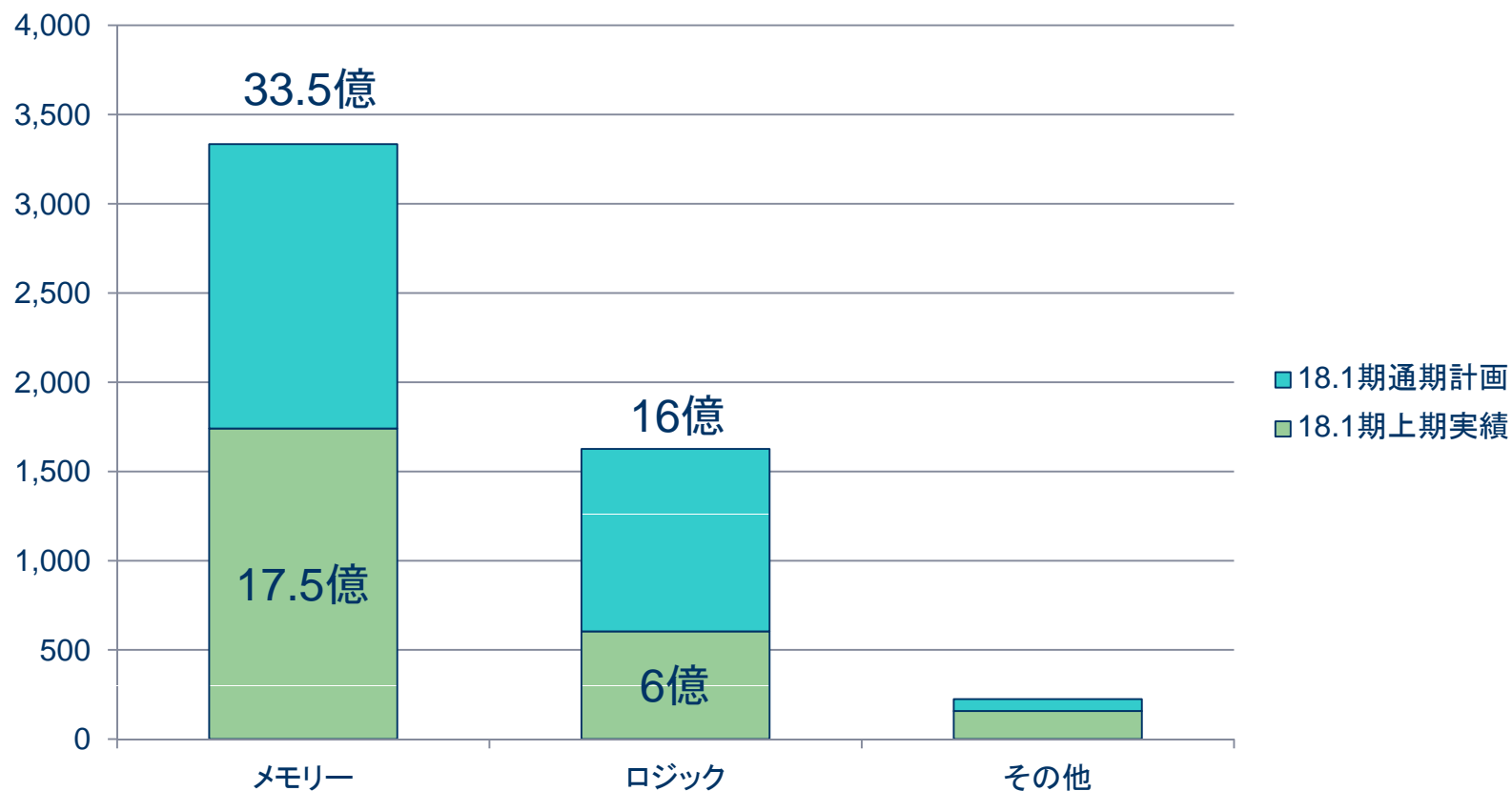


※当社推定による概算値

! High-k、Metal向け材料を中心とした成長を目論む

売上進捗分析(半導体向け先別)

単位:百万円



※当社推定による概算値

！メモリー向けは想定以上の進捗

2018年1月期下期の見通し

外部環境見通しなど

1. 半導体工場の稼働は好調を維持
2. 太陽電池市場は回復までに想定より手間取るか
3. 光ファイバー市場は好調も原材料価格は低水準で安定
4. 想定レートは\$1=¥110 感応度は1円で約1千万円

下期の施策

1. 韓国JVの本格稼働のための協力体制強化
2. 新規材料(Metal、High-k材料等)の生産性向上

3. 中期経営計画各施策の進捗について

1.上野原第二工場増築(1)



！ 来期以降の成長を達成するための源泉

1.上野原第二工場増築(2)

危険物製造棟他
3棟新築

非危険物
製造エリア増築
(2,3F増築)



！色つきのエリアを増・新築予定

2.SK Tri Chem Co., Ltd.(韓国合弁会社)



세종특별자치시
미온하쿠工業団地内
事業内容 プレカーサー製造
従業員数 30人(2017年2月)
敷地面積 10,290㎡



！ 現在最終ユーザーにおいて製品評価中

3.三化電子材料股份有限公司(台湾子会社)

- 工場建設のための設計会社選定中
- 各種許認可取得後、来年春以降着工の見込み

4.計画策定時の外部環境予測→ほぼ想定通りの推移、変更なし

➤ 半導体市場は当面成長を持続

➤ 半導体微細化により材料、プロセスは進化
(新材料ニーズ・3D積層等)

➤ 太陽電池市場は低迷、光ファイバー市場は横ばい程度

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先: homepageinfo2@trichemical.com

用語集(Page 9・16)

Impla

Ion Implantation=イオン注入。半導体に使用されるSi(シリコン)は本来電気を通しにくい物質ですが、ホウ素やリン等のイオンを注入することで、条件によって絶縁性能が変化する「半導体」となります。

Etch

Etching(エッチング)。ウエハ上に積んだ膜のうち、不要なものを化学反応により削る工程です。

CVD材料

CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長)法とは、化学材料の蒸気を熱などにより分解しウエハ上に堆積させる技術であり、**CVD材料**とはその際に用いられる化学材料を指します。堆積させる薄い膜は絶縁膜や金属・導体膜・半導体膜であり、使用される材料は多岐にわたっております。

また、半導体の微細化・高性能化を進めるために、従来の製法・材料では解決できない電気的な問題を解決するための誘電率の低い膜が得られる低誘電率層間絶縁膜(Low-k)材料や逆に誘電率の高い膜が得られる高誘電率絶縁膜(**High-k**)材料・物理的な問題を解決するための金属窒化膜(**Metal**)材料などといった新たなニーズに対応するための材料をいち早く提案し、安定供給するのが当社の特徴であります。